

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

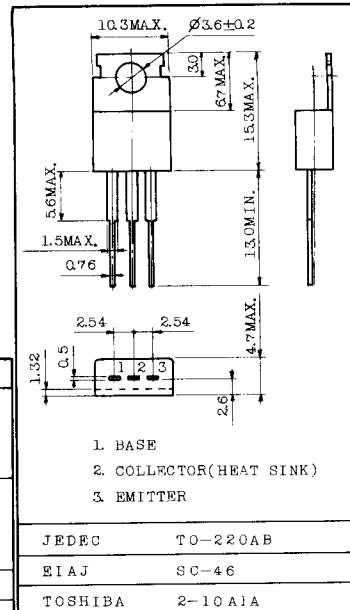
2SA968・2SA968A
2SA968B

- 電力増幅率
- 励振段電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- Driver Stage Amplifier Applications.

- ・ トランジション周波数が高い。: $f_T=100\text{MHz}$ (Typ.)
- ・ 2SC2238 とコンプリメンタリになります。
- ・ Can Type (TO-66) の 2SA969 もあります。
- ・ Complementary to 2SC2238.

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	2SA968	-160	V
	2SA968A	-180	
	2SA968B	-200	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA968	-160	V
	2SA968A	-180	
	2SA968B	-200	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	A
エミッタ電流	I_E	1.5	A
コレクタ損失 (Tc=25°C)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~150	°C



アクセサリは AC75 を適用
MOUNTING KIT No. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゝ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-160\text{V}, I_E=0$	-	-	-1.0	μA
エミッタしゝ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$	-	-	-1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SA968	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$	-160	-	-	V
	2SA968A		-180	-	-	
	2SA968B		-200	-	-	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-1\text{mA}, I_C=0$	-5	-	-	V
直流電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	70	-	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$	-	-	-1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-500\text{mA}$	-	-	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	-	100	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$	-	30	-	pF

Note: h_{FE} 区分/ h_{FE} classification O: 70~140, Y: 120~240